

2SD1341P



シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ
T. V. 水平偏向出力用

暫定規格

絶対最大定格 / Ta = 25°C

コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	800	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	7	V
コレクタ電流	I _C	5	A
ピークコレクタ電流	i _{cp}	16	A
コレクタ損失	P _C	50	W
接合部温度	T _j	150	°C
保存周囲温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C

電気的特性 / Ta = 25°C

項目	条件	規格			単位
		MIN	TYP	MAX	
コレクタ遮断電流 I _{CB0}	V _{CB} = 800V, I _E = 0			10	μA
コレクタ維持電圧 V _{CE0} (sus)	I _C = 100mA, I _B = 0	800			V
エミッタ遮断電流 I _{EBO}	V _{EB} = 5V			1	mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧 V _{CE} (sat)	I _C = 4A, I _B = 0.8A			5	V
ベース・エミッタ飽和電圧 V _{BE} (sat)	I _C = 4A, I _B = 0.8A			1.5	V
直流電流増幅率 h _{FE}	V _{CE} = 5V, I _C = 1A	8			
降下時間 t _f	I _C = 4A, I _{B1} = 0.8A, I _{B2} = -1.6A			0.7	ns

f_T

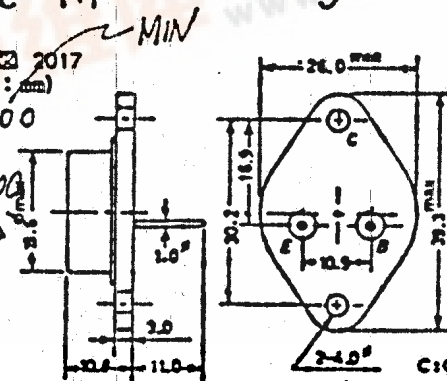
V_{CE} = 10V, I_C = 1A

3

MHz

コレクタ・ベース降伏電圧 V_{(BR)CB0} I_C = 5mA, I_E = 0 1500
 コレクタ・エミッタ " V_{(BR)CE0} I_C = 100mA, R_{BE} = ∞ 800
 エミッタ・ベース " V_{(BR)EBO} I_E = 200mA, I_C = 0 ?

外形図 2017 (unit: mm)



EIAJ. TC-3, TB-3
JEDEC. TO-18

C: Collector
E: Emitter
B: Base

